

2SA661

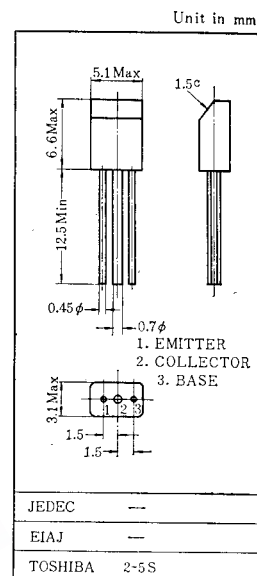
シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ (PCT方式)
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

- 励振段増幅用 ○ 電圧増幅用
○ Driver Stage and Amplifier Applications.
○ High Voltage Amplifier Applications.

- ・高耐圧です: $V_{CE0} \geq -50V$
- ・許容コレクタ損失が大きい: $P_C = 600mW$ ($T_a = 25^\circ C$)
- ・2SC1166とコンプリメンタリになります。
- ・Complementary to 2SC1166

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	-50	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-200	mA
エミッタ電流	I_E	200	mA
コレクタ損失	P_C	600	mW
接合温度	T_j	150	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$



アクセサリはRH-16を適用
RADIATOR HOLDER RH-16

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -20V, I_E = 0$	—	—	-100	nA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-100	nA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C = -10mA, I_B = 0$	-50	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E = 0.1mA, I_B = 0$	-5	—	—	V
直流電流増幅率	(Note) $h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -50mA$	40	100	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -200mA$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -100mA, I_B = -10mA$	—	—	-0.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -2V, I_C = -200mA$	—	—	1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -10V, I_E = 10mA$	70	100	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	9	—	pF

Note ; $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SA661 is classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA661—R	40	80
2SA661—O	70	140
2SA661—Y	120	240
2SA661—GR	200	400

